= ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 541.123/.123.8/9:546.56'81'86/23

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Cu₂Se-SnSe-CuSbSe₂

© 2019 г. Э. Н. Исмаилова¹, Л. Ф. Машадиева^{1, *}, И. Б. Бахтиярлы¹, М. Б. Бабанлы¹

¹Институт катализа и неорганической химии им. М. Нагиева НАН Азербайджана, пр-т Г. Джавида, 113, Баку, AZ-1143 Азербайджан

> **E-mail: leylafm76@gmail.com* Поступила в редакцию 13.06.2018 г. После доработки 15.11.2018 г. Принята к публикации 23.11.2018 г.

Методами дифференциального термического и рентгенофазового анализа изучены фазовые равновесия в системе $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$. Сплавы получены сплавлением предварительно синтезированных и идентифицированных исходных соединений в вакууме с последующим отжигом при 650 К в течение 500 ч. Построены политермические сечения $SnSe-Cu_3SbSe_3$, $Cu_2Se-[A]$, $CuSbSe_2-[B]$, где [A] и [B] – сплавы состава $(SnSe)_{0.5}(CuSbSe_2)_{0.5}$ и $(Cu_2Se)_{0.5}(SnSe)_{0.5}$ соответственно, и изотермическое сечение при 300 К фазовой диаграммы, а также проекция поверхности ликвидуса. Показано, что данная система является квазитройной плоскостью четверной системы Cu-Sn-Sb-Se и характеризуется нонвариантными переходным и эвтектическим равновесиями. Определены поля первичной кристаллизации фаз, типы и координаты нон- и моновариантных равновесий. Выявлены широкие области твердых растворов на основе SnSe и CuSbSe₂.

Ключевые слова: фазовая диаграмма, поверхность ликвидуса, селениды меди-сурьмы, моноселенид олова **DOI:** 10.1134/S0044457X19060096

введение

Тройные халькогениды меди и серебра на протяжении многих лет вызывают большой интерес благодаря тому, что многие из них проявляют фотоэлектрические, термоэлектрические, нелинейные оптические и др. свойства, а также смешанную электронно-ионную проводимость. Это делает их перспективными для применения в качестве преобразователей энергии, электродных материалов, составных элементов аналоговых интеграторов, твердотельных топливных элементов, ионисторов, электрохромных визуализаторов, ионоселективных электродов и т.д. [1-9]. В частности, системы Cu–Sb–Sn–X (X = S, Se) представляют большой практический интерес в связи с возможностью разработки на их основе новых экологически безопасных термоэлектрических материалов. Согласно результатам исследований последних лет, некоторые фазы с общей формулой $Cu_{12 - x}M_xSb_4S_{13 - y}Se_y$ (M = Zn, Sn, Fe, Со, Ni и т.д.) – производные от синтетического аналога минерала тетраэдрита Cu₁₂Sb₄S₁₃ – демонстрируют высокие значения коэффициента термоэлектрической добротности (ZT = 1) в среднетемпературном диапазоне (600-800 К), что сопоставимо или превышает значения ZT для классических коммерческих термоэлектриков на основе теллуридов свинца и висмута [10-20].

Для разработки научных основ синтеза новых многокомпонентных фаз и материалов целесообразно исследовать фазовые равновесия и термодинамические свойства соответствующих систем [21, 22]. Ранее нами [23–28] были проведены подобные комплексные исследования сложных систем на основе халькогенидов меди.

В настоящей работе представлены новые экспериментальные данные по фазовым равновесиям в квазитройной системе $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$ (I).

Все исходные компоненты системы I плавятся конгруэнтно. Соединение Си₂Se плавится при 1403 К, претерпевая полиморфное превращение при 396 К [29] и имеет область гомогенности в сторону избытка селена, максимальную при 800 К (33.3-36.6 ат. % Se). Высокотемпературная модификация селенида меди кристаллизуется в кубической решетке (пр. гр. $Fm\overline{3}m$) с параметром a = 5.859(1) Å, а низкотемпературная имеет моноклинную решетку (пр. гр. C2/c) с параметрами: $a = 7.1379(4), b = 12.3823(7), c = 27.3904(9) Å, \beta = 94.308°$ [30]. Соединение SnSe плавится при 1153 К [29] и кристаллизуется в орторомбической решетке (пр. гр. *Рстп*) с параметрами: *a* = 4.44175 (7), b = 4.15096 (5), c = 11.49417 (12) Å [31]. Соединение CuSbSe₂ плавится конгруэнтно при 760 К [2] (при 753 К по данным [32], при 765 К по данным [33]), имеет алмазоподобную структуру и кристаллизуется в орторомбической решетке (пр. гр. Pnma) с параметрами: *a* = 6.467, *b* = 4.045, *c* = 15.048 Å; *Z* = = 4 [34].

Граничные квазибинарные системы $Cu_2Se-SnSe$, $Cu_2Se-CuSbSe_2$ и $SnSe-CuSbSe_2$ изучены в



Рис. 1. Фазовая диаграмма системы SnSe-CuSbSe₂ [38].



Рис. 2. Изотермическое сечение при 300 К фазовой диаграммы системы $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$. Пунктиры – разрезы $Cu_2Se-[A]$ и $CuSbSe_2-[B]$. **1** и **2** – сплавы, порошковые рентгенограммы которых представлены на рис. **3**.

работах [2, 33, 35–38]. Система $Cu_2Se-SnSe$ имеет фазовую диаграмму простого эвтектического типа с координатами эвтектики 813 К и 46 мол. % Cu_2Se [35].

В системе Cu₂Se–CuSbSe₂ образуется одно тройное соединение Cu₃SbSe₃, плавящееся инконгруэнтно при 808 К [2, 33] (по данным [36], при 800 К) и кристаллизующееся в орторомбической решетке (пр. гр. *Pnma*) с параметрами: a == 7.9865(8), b = 10.6138(9), c = 6.8372(7) Å, Z = 4 [37]. В системе при 748 К кристаллизуется эвтектический расплав состава 90 мол. % CuSbSe₂ [2, 33].

Фазовая диаграмма граничной системы SnSe– CuSbSe₂ (рис. 1) построена нами [38] на основании данных дифференциального термического (ДТА) и рентгенофазового анализа (РФА). Диаграмма системы эвтектического типа с ограниченной растворимостью на основе исходных соединений. Эвтектика имеет состав ~63 мол. % CuSbSe₂ и кристаллизуется при 700 К. Растворимость на основе SnSe (β -фаза) и CuSbSe₂ (γ -фаза) максимальна при эвтектической температуре и составляет ~25 и 5 мол. % соответственно.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для экспериментов использовали простые вещества фирмы Evochem Advanced Materials GMBH (Германия) высокой степени чистоты: медь в гранулах (Cu-00029, 99.9999%), сурьму в гранулах (Sb-00002, 99.999%), олово в гранулах (Sn-00005, 99.999%), селен в гранулах (Se-00002, 99.999%). Бинарные и тройные соединения для исследования фазовых равновесий в системе I синтезировали сплавлением простых вешеств в стехиометрических соотношениях в вакуумированных до ~10⁻² Па и запаянных кварцевых ампулах при температурах на 50° выше температур плавления синтезируемых соединений. При синтезе соединений CuSbSe₂ и Cu₃SbSe₃ ампулы с навесками нагревали до 800 и 850 К соответственно, полученные расплавы выдерживали при этих температурах в течение 3-4 ч. После синтеза ампулу с CuSbSe₂ охлаждали в режиме выключенной печи до 300 К. Учитывая инконгруэнтный характер плавления Cu₃SbSe₃ и рекомендации работы [39], после синтеза ампулу с этим соединением быстро охлаждали из расплава, а затем отжигали при 600-673 К. Синтез соединений Си₂Se и SnSe проводили в двухзонной наклонной печи. Температура нижней "горячей" зоны для Cu₂Se и SnSe coставляла 1420 и 1200 К соответственно, а верхней "холодной" – 900 К, что несколько ниже точки кипения селена (958 К [40]). Для получения однородного Cu₂Se стехиометрического состава после синтеза проводили закалку от температуры 1300 К в холодную воду [41].

Индивидуальность всех синтезированных соединений контролировали методами ДТА и РФА. Полученные температуры плавления и параметры кристаллических решеток всех синтезированных соединений в пределах погрешности (±3 К и ±0.0003 Å) были близки к вышеуказанным литературным значениям.

Для проведения экспериментов сплавлением исходных соединений в условиях вакуума были приготовлены 36 сплавов, составы которых находятся по разрезам SnSe–Cu₃SbSe₃, Cu₂Se–[A] и CuSbSe₂–[B] ([A] и [B] – сплавы состава (SnSe)_{0.5}(CuSbSe₂)_{0.5} и (Cu₂Se)_{0.5}(SnSe)_{0.5} соответственно), а также ряд дополнительных сплавов вне их. По данным ДТА литых негомогенезированных сплавов, их кристаллизация из расплавов завершается при 685 К. С учетом этого для достижения состояния, максимально близкого к равновесному, литые сплавы, полученные быстрым охлаждением расплавов, были отожжены при 650 К



Рис. 3. Порошковые дифрактограммы сплавов **1** (40 мол. % SnSe-60 мол. % Cu₃SbSe₃) и **2** (60 мол. % Cu₂Se-20 мол. % SnSe-20 мол. % CuSbSe₂).

в течение 500 ч. При визуальном наблюдении отожженных образцов состава 90—95 мол. % Cu_2Se по разрезу Cu_2Se —[A] были обнаружены следы металлической меди, что связано с отклонением полуселенида меди от стехиометрии.

ДТА проводили в интервале температур от комнатной до 1400 К со скоростью нагревания 10 град/мин на дифференциальном сканирующем калориметре 404 F1 Pegasus System фирмы Netzsch. Результаты измерений обрабатывали с помощью программного обеспечения Netzsch Proteus Software. Точность измерения температуры составляла ±2 К. РФА проводили при комнатной температуре на дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker с $CuK_{\alpha l}$ -излучением. Рентгенограммы индексировали с помощью программы Topas V3.0 Software Bruker.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Совместная обработка всех полученных экспериментальных результатов с использованием литературных данных по боковым системам $Cu_2Se-SnSe$ [35], $Cu_2Se-Sb_2Se_3$ [2, 33] и $SnSe-CuSbSe_2$ [38] позволила получить взаимосогласованную картину фазовых равновесий в системе $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$.



Рис. 4. Проекция поверхности ликвидуса системы $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$. Поля первичной кристаллизации: $1 - \alpha$, $2 - \beta$, $3 - \gamma$, $4 - Cu_3SbSe_3$.

Фазовые соотношения при комнатной температуре. На рис. 2 представлена диаграмма твердофазных равновесий в системе I, которая наглядно показывает расположение фазовых областей при комнатной температуре. В-Фаза образует коноды с низкотемпературной модификацией Cu₂Se и соединением Cu₃SbSe₃, а у-фаза – только с соединением Cu₃SbSe₃. В результате концентрационный треугольник делится на три двухфазные и две трехфазные области. Фазовые составы сплавов подтверждены рентгенографически. В качестве примера на рис. 3 представлены порошковые дифрактограммы сплава 1 состава 40 мол. % SnSe-60 мол. % Cu₃SbSe₃ и сплава 2 состава 60 мол. % Cu₂Se-20 мол. % SnSe-20 мол. % CuSbSe₂ (рис. 2). Видно, что сплав 1 состоит из двухфазной смеси β + Cu₃SbSe₃, а сплав **2** – из трехфазной смеси $(Cu_2Se)_1 + \beta + Cu_3SbSe_3$. Из данных порошковых рентгенограмм вычислены следующие параметры элементарных ячеек соединений: $Cu_2Se - моноклинная решетка, пр. гр. C2/c, a =$ = 7.1381(6), b = 12.3819(5), c = 27.3917(7) Å, $\beta =$ = 94.308°; β (SnSe) – орторомбическая решетка, пр. гр. *Pcmn*, a = 4.4416(5), b = 4.1508(4), c == 11.4941(9) Å; Cu₃SbSe₃ – орторомбическая решетка, пр. гр. *Рпта*, a = 7.9867(6), b = 10.6140(6), c = 6.8374(5) Å, которые практически совпадают с результатами [30, 31, 34]. Незначительная разница между параметрами решетки β-фазы и SnSe стехиометрического состава обусловлена тем, что составы этих фаз отличаются не более чем на 2-3 мол. %.

Поверхность ликвидуса. Ликвидус системы Cu₂Se–SnSe–CuSbSe₂ (рис. 4) состоит из полей первичной кристаллизации α-, β- и γ-фаз, а также тройного соединения Cu₃SbSe₃ (соответственно поля 1, 2, 3 и 4 на рис. 4). Наибольшую протяженность имеет поверхность ликвидуса α-фазы на основе самого тугоплавкого соединения системы. Поля первичной кристаллизации фаз разграничены одной перитектической (*pU*) и четырьмя эвтектическими (e_2U , UE, e_1E , e_3E) кривыми. Кривые, исходящие из перитектической точки р и эвтектической точки е2, сходятся в переходной точке U, отвечающей составу расплава, находящегося в нонвариантном равновесии $L + \alpha \leftrightarrow \beta +$ + Cu₃SbSe₃. В подсистеме Cu₂Se-SnSe-Cu₃SbSe₃ эта реакция завершается при избытке α-фазы и ниже солидуса образуется трехфазная область α + $+\beta$ + Cu₃SbSe₃. В области составов SnSe-CuSbSe₂-Cu₃SbSe₃ кристаллизация завершается эвтектическим процессом Е и в результате формируется трехфазная область $\beta + \gamma + Cu_3SbSe_3$. Типы и координаты нонвариантных равновесий. а также температурные интервалы моновариантных равновесий приведены в табл. 1. Составы в точках U и E определены сопоставлением экспериментальных данных по трем политермическим разрезам, описание которых приведено ниже.

Политермические сечения

Ниже приведены и описаны в контексте с рис. 2 и 4 политермические разрезы SnSe-Cu₃SbSe₃, Cu₂Se-[A] и CuSbSe₂-[B].

Разрез SnSe-Cu₃SbSe₃ (рис. 5). Результаты РФА отожженных сплавов этого разреза показали, что они являются двухфазными смесями исходных соединений. Это указывает на стабильность данного разреза ниже солидуса. На основа-ДТА построен полученных данных нии политермический разрез SnSe-Cu₃SbSe₃ фазовой диаграммы системы I (рис. 5). Этот разрез является стабильным ниже солидуса сечением системы $Cu_2Se-SnSe-Sb_2Se_3$, но неквазибинарным в силу инконгруэнтного характера плавления соединения Cu₃SbSe₃. В системе наблюдается растворимость на основе SnSe (β-фаза) с протяженностью ~3 мол. %.

Ликвидус состоит из двух ветвей, характеризующих первичную кристаллизацию β -фазы и твердых растворов на основе высокотемпературной модификации соединения Cu₂Se (α -фаза). Ниже ликвидуса в интервале составов 0–30 мол. % SnSe наблюдаются термические эффекты, относящиеся к моновариантной перитектической реакции L + $\alpha \leftrightarrow$ Cu₃SbSe₃. В ходе этой реакции формируется трехфазная область L + α + Cu₃SbSe₃. В интервале составов 30–95 мол. % SnSe происходит совместная кристаллизация α - и β -фаз. Горизонталь при 725 К отвечает нонвариантной переходной реакции (U): L + $\alpha \leftrightarrow$



Рис. 5. Политермическое сечение SnSe-Cu₃SbSe₃ фазовой диаграммы системы I.

 \leftrightarrow Cu₃SbSe₃ + β . Поскольку данный разрез стабилен ниже солидуса, в этой реакции обе исходные фазы полностью расходуются и образуется двухфазная смесь Cu₃SbSe₃ + β . **Разрез Cu₂Se–[A]** (рис. 6). В субсолидусе этот разрез проходит через фазовые поля α + Cu₃SbSe₃ + β , Cu₃SbSe₃ + β и Cu₃SbSe₃ + β + γ (рис. 2). Ликвидус состоит из двух ветвей, отвечающих первичной

Таблица 1. Нон- и моновариантные равновесия в системе Cu₂Se-SnSe-CuSbSe₂

| Точка или кривая на рис. 4 | Равновесие | Состав, мол. % | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|---------|
| | | Cu ₂ Se | CuSbSe ₂ | SnSe | Ι, Κ |
| <i>e</i> ₁ | $L \leftrightarrow \beta + \gamma$ | _ | 63 | 37 | 700 |
| e_2 | $L \leftrightarrow \alpha + \beta$ | 46 | — | 54 | 815 |
| <i>e</i> ₃ | $L \leftrightarrow \gamma + Cu_3SbSe_3$ | 10 | 90 | — | 748 |
| р | $L + \gamma \leftrightarrow Cu_3SbSe_3$ | 30 | 70 | — | 808 |
| U | $L + \alpha \leftrightarrow \beta + Cu_3SbSe_3$ | 22 | 47 | 31 | 725 |
| E | $L \leftrightarrow \beta + \gamma + Cu_3SbSe_3$ | 6 | 60 | 34 | 685 |
| e_2U | $L \leftrightarrow \alpha + \beta$ | | | | 815-725 |
| pU | $L + \gamma \leftrightarrow Cu_3SbSe_3$ | | | | 808-725 |
| e_1E | $L \leftrightarrow \beta + \gamma$ | | | | 700-685 |
| e_3E | $L \leftrightarrow \gamma + Cu_3SbSe_3$ | | | | 748–685 |
| UE | $L \leftrightarrow \beta + Cu_3SbSe_3$ | | | | 725-685 |



Рис. 6. Политермическое сечение Cu₂Se-[A] фазовой диаграммы системы I.

кристаллизации α -фазы на основе высокотемпературной модификации Cu₂Se и β -фазы на основе SnSe. После первичной кристаллизации α - и β -фаз наблюдается моновариантная кристаллизация эвтектической смеси $\alpha + \beta$ (в области составов 20–95 мол. % Cu₂Se). Кривые *UE* и *e*₁*E* относятся к моновариантным эвтектическим равновесиям. Горизонталь при 725 К характеризует нонвариантное переходное равновесие *U*, а при 685 К – кристаллизацию тройной эвтектики (табл. 1). После завершения этих процессов формируются трехфазные области $\alpha + \beta + Cu_3SbSe_3$ и $\beta + \gamma + Cu_3SbSe_3$. Горизонталь при 390 К соответствует фазовому переходу Cu₂Se, который протекает по эвтектоидной реакции:

$$\alpha \leftrightarrow (Cu_2Se)_I + Cu_3SbSe_3 + \beta.$$
(1)

На рис. 7 представлены кривые ДТА нагревания некоторых сплавов по разрезу Cu₂Se-[A]. Их сравнение с рис. 6 показывает, что термические эффекты по своим характеристикам (температура, интенсивность, четкость или размытость пиков) находятся в соответствии с фазовой диаграммой. Например, на термограмме сплава состава 60 мол. % Cu₂Se четкие эндоэффекты при 390 и 725 К соответствуют эвтектоидной реакции (1) и переходной реакции *U*, а размытые пики при \leq 770 и \leq 995 К — моновариантному эвтектическому процессу *e*₂*U* и концу плавления α -фазы.

Разрез CuSbSe₂–[B] (рис. 8). Этот разрез проходит через поля первичной кристаллизации α - и γ -фаз, а также тройного соединения Cu₃SbSe₃. Ниже линии ликвидуса расположены кривые, отвечающие моновариантным процессам e_2U (0–42 мол. % CuSbSe₂), pU (42–52 мол. % CuSbSe₂), UE (47– 57 мол. % CuSbSe₂), e_3E (57–90 мол. % CuSbSe₂) и e_1E (90–95 мол. % CuSbSe₂). В интервале составов 3–35 мол. % CuSbSe₂ при завершении переходной



Рис. 7. Термограммы нагревания некоторых сплавов по разрезу Cu₂Se-[A].



Рис. 8. Политермическое сечение CuSbSe₂-[B] фазовой диаграммы системы I.

реакции U (табл. 1) α -фаза остается в избытке и формируется трехфазная область $\alpha + \beta +$ + Cu₃SbSe₃, а в интервале 42–92 мол. % CuSbSe₂ кристаллизация завершается нонвариантным эвтектическим процессом E и образуется трехфазная область $\beta + \gamma + Cu_3SbSe_3$. На данном разрезе указаны также двухфазные области $\beta + Cu_3SbSe_3$ и $\gamma + Cu_3SbSe_3$, протяженности которых находятся в соответствии с диаграммой твердофазных равновесий (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены новые экспериментальные данные по фазовым равновесиям в квазитройной системе $Cu_2Se-SnSe-CuSbSe_2$, включающие политермические разрезы $SnSe-Cu_3SbSe_3$, $Cu_2Se-[A]$ и $CuSbSe_2-[B]$, изотермическое сечение при 300 К фазовой диаграммы, а также проекцию поверхности ликвидуса. Установлено, что поверхность ликвидуса состоит из полей первичной кристализации α -, β - и γ -фаз, а также Cu_3SbSe_3 . Определены типы и координаты нон- и моновариантных равновесий. В системе выявлены широкие области твердых растворов на основе SnSe и CuSbSe_2.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской республики (грант № EİF-BGM-4-RFTF-1/2017-21/11/4-М-12).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Applications of Chalcogenides: S, Se, and Te / Ed. Ahluwalia G.K. 2016. Cham.: Springer, 461 p.
- Бабанлы М.Б., Юсибов Ю.А., Абишев В.Т. Трехкомпонентные халькогениды на основе меди и серебра. Баку: Изд-во БГУ, 1993. 342 с.
- 3. *Lin Y., Fang S., Su D. et al.* // Nat. Commun. 2015. V. 6. Article № 6824. doi 10.1038/ncomms7824
- Yokota I., Miyatani S. // Solid State Ionics. 1981. V. 3–4. P. 17. doi 10.1016/0167-2738(81)90047-3
- 5. *Xia Z., Fang H., Zhang X. et al.* // Chem. Mater. 2018. V. 30. № 3. P. 1121. doi 10.1021/acs.chemmater.7b05104
- 6. Chen D., Zhao Y., Chen Y. et al. // Adv. Electron. Mater. 2016. V. 2. № 6. P. 1500473. doi 10.1002/aelm.201500473
- Wang Q., Li J., Li J. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2018.
 V. 20. № 3. P. 1460. doi 10.1039/C7CP06465A
- Xiao Ch. Synthesis and Optimization of Chalcogenides Quantum Dots Thermoelectric Materials. Springer, 2016. 114 p.
- 9. *Qiu P., Agne M.T., Liu Y. et al.* // Nat. Commun. 2018. V. 9. Article № 2910. doi 10.1038/s41467-018-05248-8
- Lu X., Morelli D.T., Wang Y. et al. // Chem. Mater. 2016. V. 28. № 6. P. 1781. doi 10.1021/acs.chemmater.5b04796

- 11. Sun F.-H., Wu C.-F., Li Z. et al. // RSC Advances. 2017. V. 7. № 31. P. 18909. doi 10.1039/c7ra02564e
- Wang L., Yang B., Xia Z. et al. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2016. V. 144. P. 33. doi 10.1016/j.solmat.2015.08.016
- 13. *Chetty R., Bali A., Mallik R.C.* // J. Mater. Chem. C. 2015. V. 3. № 48. P. 12364. doi 10.1039/c5tc02537k
- Prem-Kumar D.S., Ren M., Osipowicz T. // Sol. Energy. 2018. V. 174. P. 422. doi 10.1016/j.solener.2018.08.080
- 15. *Weller D.P., Stevens D.L., Kunkel G.E. et al.* // Chem. Mater. 2017. V. 29. № 4. P. 1656. doi 10.1021/ acs.chemmater.6b04950
- Wang J., Gu M., Bao Y. et al. // J. Electron. Mater. 2016.
 V. 45. № 4. P. 2274. doi 10.1007/s11664-015-4301-8
- 17. *Sun F.-H., Dong J., Dey S. et al.* // Sci. China Mater. 2018. V. 61. № 9. P. 1209. doi 10.1007/s40843-018-9241-x
- Suekuni K., Takabatake T. // Appl. Mater. 2016. V. 4. P. 104503. doi 10.1063/1.4955398
- Nasonova D.I., Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Shevelkov A.V. // Chem. Mater. 2016. V. 28. P. 6621. doi 10.1021/ acs.chemmater.6b02720
- Kim F.S., Suekuni K., Nishiate H. et al. // J. Appl. Phys. 2016. V. 119. P. 175105. doi 10.1063/1.4948475
- Villars P., Prince A., Okamoto H. Handbook of Ternary Alloy Phase Diagrams (10 volume set). USA: ASM Int. Publ., 1995. 15000 p.
- Babanly M.B., Chulkov E.V., Aliev Z.S. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62. № 13. P. 1703. doi 10.1134/S0036023617130034
- Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Bagheri S.M. et al. // J. Alloys Compd. 2017. V. 691. P. 255. doi 10.1016/j.jallcom.2016.08.251
- Mashadiyeva L.F., Gasanova Z.T., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. // Russ. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62.
 № 5. Р. 598. doi 10.1134/S0036023617050151 [Машадиева Л.Ф., Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 5. С. 599.]
- Gasanova Z.T., Mashadiyeva L.F., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. // Russ. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62.
 № 5. Р. 591. doi 10.1134/ S0036023617050126 [Гасанова З.Т., Машадиева Л.Ф., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 5. С. 592.]
- Mashadieva L.F., Gasanova Z.T., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. // Inorg. Mater. 2018. V. 54. № 1. Р. 8. doi 10.1134/ S0020168518010090 [Машадиева Л.Ф., Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. // Неорган. материалы. 2018. Т. 54. № 1. С. 11. doi 10.7868/S0044457X17050130]
- 27. Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2017. Т. 19. № 1. С. 22.
- Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Юсибов Ю.А. и др. // Электрохимия. 2018. Т. 54. № 2. С. 224. [Alverdiev I.J., Abbasova V.A., Yusibov Yu.A. et al. // Russ. J. Electrochem. 2018. V. 54. № 2. Р. 153. doi 10.1134/ S1023193518020027]

- 29. Binary Alloy Phase Diagrams / Ed. Massalski T.B. Second ed. Ohio: ASM International, Materials Park, 1990. P. 3589.
- 30. Gulay L., Daszkiewicz M., Strok O., Pietraszko A. // Chem. Met. Alloys. 2011. V. 4. P. 200.
- Sist M., Zhang J., Iversen B. // Acta Crystallogr. 2016.
 V. 72B. P. 310. doi 10.1107/S2052520616003334
- Yang C., Wang Y., Li S. et al. // J. Mater. Sci. 2012.
 V. 47. P. 7085. doi 10.1007/s10853-012-6385-3
- Головей М.И., Ткаченко В.И., Риган М.Ю., Стасюк И.П. // Неорган. материалы. 1990. Т. 26. № 5. С. 933.
- 34. Qiu W., Wu L., Ke X. et al. // Sci. Rep. 2015. V. 5. P. 13643.

- Tomashyk V., Lebrun N., Perrot P. // Landolt-Börnstein Database, MSIT, New Series IV/11C1 / Eds. Effenberg G., Ilyenko S. 2006. P. 361.
- 36. Ostapyuk T.A., Yermiychuk I.M., Zmiy O.F., Olekseyuk I.D. // Chem. Met. Alloys. 2009. V. 2. P. 164.
- Pfitzner A. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1995. V. 621. P. 685. doi 10.1002/zaac.19956210431
- 38. Ismayilova E.N., Shukurova G.M., Mashadieva L.F. // Azerbaijan Chem. J. 2018. V. 0. № 4. P. 29.
- Majsztrik P.W., Kirkham M., Garcia-Negron V. et al. // J. Mater. Sci. 2013. V. 48. P. 2188. doi 10.1007/s10853-012-6994-x
- 40. Эмсли Дж. Элементы. М.: Мир, 1993. 256 с.
- 41. *Глазов В.М., Бурханов А.С., Салеева Н.М.* // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1977. Т. 13. № 5. С. 917.